



SOITEC ANNONCE LA DISPONIBILITÉ INDUSTRIELLE DE SA PLATE-FORME FULLY-DEPLETED (FD) : UNE SOLUTION CLE POUR ACCROITRE LES PERFORMANCES DES PRODUITS MOBILES GRAND PUBLIC

Cette nouvelle plate-forme permet d'exploiter la technologie FD planaire, seule solution planaire capable de soutenir la loi de Moore

Salon Semicon West, San Francisco, Californie, le 12 juillet 2010 - Soitec (Euronext Paris), premier fabricant mondial de substrats innovants pour l'industrie micro-électronique, annonce qu'elle dispose d'une plate-forme industrielle UTSOI complète (Ultra-Thin Silicon-on-Insulator), incluant la gamme BOX très mince (Ultra-Thin Buried Oxide). Soitec est ainsi en mesure de proposer une solution robuste de substrats aux concepteurs de circuits intégrés confrontés aux défis de performance, de consommation et de densité inhérents aux produits mobiles grand public. Les transistors planaires FD sont désormais considérés par les industriels comme la solution optimale pour la technologie CMOS aux générations 22 nm et au-delà. En intégrant la technologie de transistors planaires FD sur les plaques UTBOX, les concepteurs de circuits intégrés peuvent maximiser les bénéfices des techniques qu'ils utilisent actuellement. Une capacité de fabrication en fort volume est disponible pour le nœud 22 nm sur les sites de production dont dispose Soitec en France et à Singapour.

« Les plaques UTBOX de SOITEC sont prêtes pour les architectures planaires FD : l'infrastructure, la maturité du procédé, le rendement et le potentiel en capacité de production sont en place pour répondre à la demande », déclare André-Jacques Auberton-Hervé, Président-Directeur général de Soitec. « Les leaders industriels confirment que la technologie planaire FD constitue le bon choix pour les produits mobiles destinés au grand public qui requièrent des performances accrues sans impact sur la consommation. Notre offre UTBOX démontre le rôle fondamental que jouent nos matériaux pour la réalisation de produits électroniques de pointe à forte efficacité énergétique ».

Grâce à la couche d'oxyde isolante ultra-mince, les concepteurs de systèmes sur puce (SoC) et les architectes système peuvent réduire la consommation et augmenter les performances de leurs applications finales tout en utilisant des techniques standard de gestion de la consommation. L'option UTBOX vient s'ajouter aux avantages actuels de la technologie FD planaire, ce qui résout les problèmes de variabilité des transistors, garantit les meilleures caractéristiques électrostatiques et permet un fonctionnement des mémoires SRAM avec une tension d'alimentation (Vdd) moins élevée. Cette technologie évolutive, qui permet la fabrication en fort volume et qui met en œuvre des procédés simples et des outils de conception standard, conduit à une solution à coût optimisé.

Pour que la technologie FD tienne toutes ses promesses, les plaques de départ doivent répondre à des spécifications d'uniformité extrêmement strictes au niveau des couches de silicium supérieures. Avec une variation maximale de l'épaisseur de la couche de silicium ultra-mince supérieure de $\pm 0,5$ nm et une couche d'oxyde de seulement 10 nm d'épaisseur, ces plaques répondent parfaitement aux exigences des clients.

« Le FD SOI est la technologie qui arrive au bon moment. Alors que les solutions pour réduire les pertes sur silicium massif deviennent de plus en plus coûteuses et de moins en moins fiables, le FD SOI offre une solution simple. De plus, comme le FD SOI est une technologie planaire et extensible, pour laquelle



les étapes de la fabrication sont indépendantes les unes des autres, elle permet un transfert homogène des designs actuels sur cette technologie. C'est une combinaison performante », a déclaré Horacio Mendez, Directeur Exécutif du Consortium industriel SOI.

Soitec sera présent au salon Semicon West (stand 1333) qui se tient dans le Hall Sud du Moscone Convention Center de San Francisco du 13 au 15 juillet.

À propos de Soitec

Soitec est le leader mondial dans la fourniture de substrats innovants pour l'industrie microélectronique de pointe. Le groupe produit une gamme étendue de matériaux avancés, notamment les plaques de silicium sur isolant (SOI) basées sur sa technologie Smart Cut™, la première application à fort volume de cette technologie. La technologie SOI apparaît aujourd'hui comme la plateforme du futur, ouvrant la voie à la production de puces plus performantes, plus rapides et plus économiques.

Aujourd'hui, Soitec fabrique plus de 80% des plaques de silicium sur isolant utilisées mondialement. Basé à Bernin, en France, où se trouvent deux unités de production à fort volume, Soitec possède des bureaux aux Etats-Unis, au Japon et à Taiwan, ainsi qu'un nouveau site de production à Singapour.

Le groupe comporte trois autres divisions : Picogiga International, Tracit Technologies et Concentrix Solar. Picogiga est spécialisé dans le développement et la fabrication de substrats innovants, depuis les plaques épitaxiées de semi-conducteurs III-V et les plaques à base de nitrure de gallium (GaN), jusqu'aux substrats composés pour la fabrication de dispositifs électroniques à haute fréquence ou optoélectroniques. Tracit est spécialisé dans la technologie de transfert de couches minces utilisée dans la production de substrats innovants destinés aux micro-systèmes et aux circuits intégrés de puissance, ainsi que dans la technologie Smart Stacking™ de transfert de circuit pour des applications telles que les capteurs d'image et l'intégration 3D. En décembre 2009, Soitec a acquis 80% de Concentrix Solar, l'un des premiers fournisseurs mondiaux de systèmes photovoltaïques à concentration (CPV). Soitec fait ainsi son entrée sur le marché en plein essor de l'industrie solaire en se positionnant sur la chaîne de valeur au niveau du système de production de l'énergie solaire.

Les actions du groupe Soitec sont cotées sur Euronext Paris.

Des informations complémentaires sont disponibles sur le site Internet www.soitec.fr.

Soitec, Smart Cut, Smart Stacking et UNIBOND sont des marques déposées de S.O.I.TEC Silicon On Insulator Technologies.

Contact Presse française

Muriel Martin, H&B Communication
+33 (0)1 58 18 32 44
m.martin@hbcommunication.fr

Relations Investisseurs

Olivier Brice
+33 (0)4 76 92 93 80
olivier.brice@soitec.fr

Contact Presse internationale

Camille Darnaud-Dufour
+33 (0)6 79 49 51 43
camille.darnaud-dufour@soitec.fr